

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成27年6月18日 (2015.6.18)

【公開番号】特開2012-253331(P2012-253331A)

【公開日】平成24年12月20日 (2012.12.20)

【年通号数】公開・登録公報2012-054

【出願番号】特願2012-105587(P2012-105587)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/8242 (2006.01)

H 0 1 L 27/108 (2006.01)

H 0 1 L 21/8247 (2006.01)

H 0 1 L 27/115 (2006.01)

H 0 1 L 29/788 (2006.01)

H 0 1 L 29/792 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 29/417 (2006.01)

H 0 1 L 27/10 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 1 L 27/06 (2006.01)

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 29/78 6 1 8 A

H 0 1 L 29/78 6 2 7 F

H 0 1 L 29/78 6 2 7 Z

H 0 1 L 29/78 6 1 8 Z

H 0 1 L 29/78 6 2 6 C

H 0 1 L 29/78 6 2 7 B

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 27/10 3 2 1

H 0 1 L 27/10 6 1 5

H 0 1 L 27/10 4 3 4

H 0 1 L 27/10 6 7 1 C

H 0 1 L 27/10 6 7 1 Z

H 0 1 L 29/78 3 7 1

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

H 0 1 L 29/50 M

H 0 1 L 27/10 4 8 1

H 0 1 L 27/10 6 2 1 Z

H 0 1 L 27/10 6 2 5 Z

H 0 1 L 27/10 4 6 1

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

H 0 1 L 27/08 1 0 2 B

H 0 1 L 27/08 1 0 2 E

H 0 5 B 33/14 A

H 0 1 L 27/06 1 0 2 A
G 0 2 F 1/1368

【手続補正書】

【提出日】平成27年4月24日(2015.4.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に第 1 の絶縁膜を形成し、
前記第 1 の絶縁膜上に第 2 の絶縁膜を形成し、
前記第 1 の絶縁膜上および前記第 2 の絶縁膜上に 1 0 0 以上 6 0 0 以下の基板温度
で酸化物半導体膜を成膜し、
前記酸化物半導体膜を成膜した後、 2 5 0 以上 6 5 0 以下の温度で加熱処理を行い
、
前記酸化物半導体膜上に第 3 の絶縁膜を成膜し、
前記第 3 の絶縁膜上にゲート電極を形成し、
前記第 1 の絶縁膜は、上面の高さが前記第 2 の絶縁膜の上面の高さと概略一致する領域
を有し、
前記第 1 の絶縁膜は、前記酸化物半導体膜に酸素を供給することができる機能を有し、
前記第 2 の絶縁膜は、酸素の拡散を抑制することができる機能を有し、
前記第 2 の絶縁膜は、前記ゲート電極と重ならない領域を有することを特徴とする半導
体装置の作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、
前記酸化物半導体膜は、I n、S nおよびZ nを含むことを特徴とする半導体装置の作
製方法。